技術報告

アルミニウム合金溶湯の脱りん技術の開発



Technical Paper

J. JFS, Vol. 88, No. 6 (2016) pp. 332~337



豊田充潤

森中真行* 豊田充潤*

Development of De-phosphorus Treatment Process for Molten Aluminum Alloy

Mayuki Morinaka* and Michihiro Toyoda*

The eutectic structure of hypoeutectic Al-Si alloy shows a modified structure when the amount of P is small, and an unmodified structure when the amount is large. We, therefore, developed a de-phosphorus treatment method which combines flux processing with rotary degassing processing to obtain the modified structure. Through this method, the amounts of gas, inclusions, as well as P could be reduced.

Keywords : Al-Si alloy, de-phosphorus, flux, rotary degassing, eutectic, modification, refractory

1. 緒 言

亜共晶 Al-Si 系合金における共晶組織は、P が少ない場 合に改良組織を示すものの, P が多い場合には非改良組織 を示すことが知られている1~10).また、それらの共晶組 織の違いにより, Fig. 1¹¹⁾ に例を示すように, 機械的性質 に違いが生じることが報告されている. 共晶組織が P に より変化する現象の報告は、1953年の Gürtler¹⁾ によるも





Al-7%Si合金の応力-ひずみ線図に及ぼすPの影響¹¹⁾.

のが最初とされている¹²⁾. 1966年には, Crosley ら¹³⁾ が亜 共晶 Al-Si 系合金において, P (AlP) が Si 相を核生成する と考察した. 1977年には, Bercovici が Fig. 2³⁾のミクロ 組織の変化を示した. P量が 0.6 ppm の場合に改良組織を 示しているのに対し, 4.3ppm の場合は非改良組織を示し ている.また、それ以降も、多くの研究者がこの現象に興 味を持ったようである. Fig. 3¹⁴⁾は, Liang らが 2014 年に



Effect of P on micro structure of Al-10%Si Fig. 2 alloy³⁾.

Al-10%Si合金のミクロ組織に及ぼすPの影響³⁾.



Fig. 3 Effect of P on modification/unmodification of Al-Si binary alloy¹⁴.

Al-Si 2元系合金の改良/非改良に及ぼすP量の影響¹⁴⁾.



Fig. 4 SEM image of Al-7%Si-0ppmP alloy¹⁵⁾. Al-7%Si-0ppmP \mathcal{O} SEM $(\mathbb{R}^{15)}$.

まとめた亜共晶 Al-Si 系合金の共晶組織(改良/非改良)に 及ぼす P の影響を再掲したものである. これより, Si 量 にもよるが, P が少ない場合に改良組織を示すことで,多 くの研究結果が一致している.

このような改良/非改良の組織の違いが生じる理由とし て、共晶セルの生成と成長の仕方に違いがあるためと考え られている^{8,14)}.まず、Pを含まない合金(改良組織)を深 腐食して SEM 観察した例を Fig. 4¹⁵⁾に示す.共晶セル(共 晶 Si 相)は初晶 α-Al 相のデンドライトの樹幹および枝間 を、主として熱流に沿って成長している様子が観察される. このような Pを含まない合金の共晶 Si 相間隔は、冷却速 度が異なる砂型、金型、銅型のいずれにおいても、Pを含 む合金よりも狭いことが報告されている¹⁶⁾.理由は次のよ うに考えられている.Pを含まない合金は溶湯中に共晶の 核物質である AlP⁵⁾が存在しない.このため、共晶セルは 鋳型の壁で熱的過冷により核生成した後、鋳物の中心部に 向かって連続して成長しているものと考えられる⁸⁾.この ように成長距離が長いにも関わらず、凝固時間は Pを含



Fig. 5 Schematic drawing of eutectic cell in case of modification.

改良組織の場合の共晶セルの模式図.



Fig. 6 Schematic drawing of eutectic cell in case of unmodification.

非改良組織の場合の共晶セルの模式図.

む合金と同じであることから,成長速度Vは比較的速いは ずである.すると、 $\lambda^2 V$ =constant^{3,17)}の関係より,Pを含 まない合金の共晶 Si 相間隔 λ はPを含む合金に比較する と狭いことになる¹⁵⁾.この場合の模式図の例として Fig. 5 を示すことができよう.

次に、Pを含む非改良の場合,Fig.6のようなモデルが 考えられる.図中の丸印は共晶セルをあらわしている.こ の場合,多くの共晶セルが主に初晶 α-Al相のデンドライ トの各枝の先端部で核生成しているものと考えられる.こ のように数多くの共晶セル数が成長する場合,凝固時間は 同じであることから,ひとつの共晶セルの成長速度は遅く なるものと考えられる.すると,共晶Si相間隔は相対的 に広くなるであろう¹⁶⁾.このことが、Pが多い場合に、非 改良組織に変化する理由のひとつと考えられる.

なお、Pを含む非改良の場合,共晶セルが初晶 α-A1 相 のデンドライトの先端部で生成しやすいことは、2005 年 に Dinnis ら¹⁸⁾ が示している.彼らは連続的に研磨したミ クロ組織の画像を3次元化することにより、**Fig. 7**¹⁸⁾ に示



Fig. 7 3D image of eutectic cell by serial sectioning micro structure¹⁸⁾. The ragged edges on plate like eutectic Si phase are a result of the difficulty in exactly matching phase boundaries in successive sections.

連続研磨によるミクロ組織を3次元化することにより得られた共晶セル像¹⁸⁾.板状の共晶Si相のギザギザのエッジは、3次元像の再構築時の位置合わせの困難さの結果である.



Fig. 8 Small protrusion of eutectic a-Al phase at tip of primary a-Al dendrite²⁰⁾. 初晶 a-Al のデンドライトの先端の微小な共晶 a-Al の突起²⁰⁾.

す共晶セルを示した. この図はやや不明瞭なものの,おお よその形態の判別は可能である. すなわち. 中心部に微小 な多面体と思われる Si 相¹⁹⁾ が存在しているようである. そこから板状の共晶 Si 相が放射状に成長しているようで ある. また, 彼らは, 共晶セルが初晶 α-Al 相のデンドラ イトの先端部で生成しやすいことを確率的に説明した。す なわち,成長する初晶 α-Al 相のデンドライトについて, 先端部の線成長と円周方向の成長の体積の差異からの説 明を試みたのである。2013年、これに関する具体的な手 がかりが見つかった. Fig. 8²⁰⁾に示された SEM 像によると, 初晶 α-Al 相のデンドライトの先端部の表面に, 共晶 α-Al 相と考えられる小さな突起が認められる。この小さな突起 の先端部では、Z方向に成長する突起の模式図をFig.9に 示すように、共晶組成からさらに溶質が濃化するであろ う. その濃化した部分は、その組成(過共晶)における液 相線温度から見れば過冷していることになる、このような 溶質濃化による組成的過冷²¹⁾は、Pの有無に関わらず生 じているものと思われる.しかしながら,共晶の核物質で ある AlP⁵⁾ が存在する場合,そこに(初晶 α-Al 相のデンド ライトの先端部)Si相が核生成されるものと考えられる.



Fig. 9 Schematic drawing for showing constitutional undercooling of tip of minute protrusions of α -Al eutectic phase.

共晶α-Al相の微小な突起の先端部が組成的過冷していることを示すための模式図.



Fig. 10 SPring-8 3D image of eutectic cell nucleated at tip of primary α -Al dendrite in Al-7%Si-8ppmP alloy¹¹. Plate like eutectic silicon had apparently grown from a polygonal Si crystal that can be seen in the center of cell.

Al-7%Si-8ppmP合金の初晶α-Alのデンドライトの先端部 で核生成した共晶セルのSPring-8における3次元像¹¹. 板状の共晶Si相はセルの中心に見られる多面体Si結晶か ら成長している.

2014年になると、SPring-8により Fig. 10¹¹⁾に示す明瞭 な共晶セルの3次元像が得られた.中心部には、多面体 と思われる微小な Si 相が認められる.そこから、板状の 共晶 Si 相が放射状に成長している.この態様は Dinnis ら ¹⁸⁾の結果に酷似している.板状の共晶 Si 相の周囲は大き くえぐれていることがわかる.これは板状の共晶 Si 相の 成長時、そこにデンドライトの先端部があったためと考え られる.また、中央部の多面体と思われる微小な Si 相の 手前は空間になっている.ここに、先ほどの小さな突起を 持つデンドライトを、向きは逆であるが模式的に書き込ん だものが Fig. 11 である.すると、微小な多面体 Si は共晶 a-Al の小さな突起の先端部に位置していることがわかる. このことから、共晶セルはデンドライト先端部で生成しや すいものと考えられる.Fig. 12²¹⁾は、少しマクロ的に観



Fig. 11 Schematic drawing added with written description of dendrite of primary crystal α -Al having small protrusion (Fig. 8) in eutectic cell image (Fig. 10). Polyhedral Si crystals was generated at the tip of the small projections.



共晶セル像 (Fig. 10) に、微小な突起をともなう初晶α-Al

Fig. 12 Eutectic cells were generated and grown at tip of primary α-Al dendrite branch²²⁾ (Al-10%Si alloy

quenched at eutectic temperature). 初晶α-Alのデンドライトの枝の先端部に生成して成長した 共晶セル (Al-10%Si合金を共晶凝固時に凍結)²²⁾.

察した2次元の組織(共晶凝固時に凍結)を示している. 共晶セルは初晶 α-Al のデンドライトの枝の先端付近で数 多く生成して成長しているようである.

以上より,改良組織を得るためには,溶湯中の核物質を 少なくすること,すなわち脱りん技術が望まれる.これま でに報告された脱 P 技術として,1997年の大城ら²³⁾によ る塩素ガスを利用する方法がある.その報告によると,P 量は12ppmから3ppmに低下している.しかしながら,大 規模な塩素ガスの処理設備を必要とすることから,一般の 鋳造業者には不向きである.また,世界的にみて,これ以 外の脱りん技術は開発されていない.このため,鋳造業者 は,購入した合金地金を脱りんすることができない状況に ある.合金地金中の P 量は配合される金属 Si の種類により 主に変化する^{24,25)}.その結果,Pが多い合金地金を使用し た場合には,鋳造製品の共晶セル数²⁶⁾,共晶組織^{8,29)},ひ け性²⁸⁾,などが変化するとともに、ポロシティ量が増加²⁹⁾ したり、逆偏析³⁰⁾が生じる可能性がある。しかしながら、 2010年に門井ら³¹⁾は Na 添加用フラックスを利用する方法 を報告した。その報告によると、P量は 8ppm から 1ppm に低下している。この場合、大掛かりな設備は不要である。 そこで本研究では、このフラックスを用いる方法に回転翼 脱ガス装置を組み合わせることにより、一般の鋳造業者が 容易に利用することのできる脱 P 技術を開発することを試 みた。

2. 実験方法

工業用の電気炉に,新品の1500番るつぼを設置した. P量が7ppmのAC4CH合金地金500kgを720℃で溶解した. 溶解に要した時間は4時間である.溶湯温度を720℃で保 持しながら,脱P処理として市販のNa添加用フラックス (NaF+NaCl=1+1)を溶湯表面に散布した.そして,Fig. 13に示すように市販の回転翼脱ガス装置で攪拌を行った. 回転速度は400rpm,Ar流量は15L/分,処理時間は10分 間である.4回の溶解を行い,フラックスの添加量を0.2%, 0.5%,1%,5%と変化させた.

採取した試料は化学成分分析用試料,減圧凝固 (5kPa) 試料,Kモールドである.化学成分は発光分光分析法によ り求めた.ガス量はランズレー法によりあらかじめ作成し た減圧凝固試料の限度見本³²⁾により判定した.介在物量 はKモールド 10 倍拡大観察法 (いわゆる K10 法)³³⁾によ り測定した.この際に重要なことは、明るい照明下で観察 することと、双眼で見ることとされている.そこで、十 分に明るい LED 照明を具備したニコン社製の実体顕微鏡 (双眼)を使用した.



Fig. 13 Schematic drawing of rotary degassing using flux.

フラックスを用いる回転翼脱ガス法の模式図.

3. 実験結果

3.1 鋳造条件

4回の実験における P 量の変化をまとめて Fig. 14³²⁾ に 示す.いずれの溶解時にも、P 量は 7ppm から 11ppm ある いは 12ppm に増加した.これらの溶湯に脱 P 処理を行っ



Fig. 14 Change of P content with holding time³²⁾. 保持時間によるP量の変化³²⁾.



Fig. 15 Change of Na content with holding time³²⁾. 保持時間によるNa量の変化³²⁾.

たところ、P量はフラックス量に応じて2~5ppm に低下 した.しかしながら、その後に溶湯保持を行うと、いずれ もP量は8ppm に増加した.これは耐火物からの混入と考 えられる³⁴⁾.また、この際のNa量の変化を**Fig.15**³²⁾ に 示す.フラックスから持ち込まれた多量のNaは、200分 が経過しても40ppm 程度が残留していた.

ガス量は減圧凝固法の限度見本に従うと、処理前の3級 (0.23cc/100gAl相当)から、処理後の1級(0.15cc/100gAl 相当)に低下した.また、K10値は従来の報告³⁵⁾と同様に、 処理前の0.2から処理後のゼロに低下した.

4. 考 察

4.1 脱P機構の推定

本実験で使用した Na 添加用フラックスの主成分は NaF である. AC4CH 合金溶湯に添加された NaF は,溶湯中の Mg により還元されるものと考えられる.かい離した Na は,溶湯中に存在する P との化合物 Na₃P を生成するもの と従来から考えられている. Na₃P は共晶の核生成能を持 たないと考えられることから,改良処理が施された状態と 認識される.また,本実験では回転翼脱ガス装置による撹 拌を行ったことから, Na₃P が酸化されて Na₃PO₄ に変化し たものと推定される.一方,フラックスのもうひとつの成 分である NaCl は,溶湯内で粘着性の高い溶融塩を形成し ているものと思われる.これが前述の Na₃PO₄ (酸化物)を 吸着あるいは包み込み,機械的に除去することにより,脱 Pが行われたものと推定することができる³⁶⁾.

4.2 耐火物からのPの混入

本実験において、溶解時および溶湯保持時に4~6ppm 程度のP量の増加が認められた.この理由として、るつ ぼからの混入が考えられる. すなわち, 一般に使用される るつぼには、骨材となる1種類もしくは複数の酸化物と、 バインダーである $P_{9}O_{5}$ とが混合されている. $P_{9}O_{5}$ は酸化 物の融点を局部的に低下させる作用がある.このため,成 形時に低い温度で焼成できることや、欠損時にバーナーの 熱により簡単に補修できるなどの利点があると考えられ ている.しかしながら、スラグラインと呼ばれる溶湯と耐 火物(酸化物)の界面では、合金溶湯の表面に存在すると 考えられる Al₂O₃や MgO などの酸化物が加わることによ り酸化物が多元化し、融点がさらに低下するものと考えら れる. これは鋳鉄において、砂(酸化物)の融点が低下し た場合に焼付きが生じる現象37)と同様の機構と考えられ る.このため、本脱りん処理時においても、耐火材のスラ グラインが局部的に溶融(液体)することにより、アルミ ニウム合金の溶湯(液体)との間で,早期に還元反応が生 じたものと思われる(液/液の反応速度). このような場 合,同時に耐火物の侵食深さが増加することが報告されて いる38).

この現象を確認するため、小型の電気炉内に本実験で 使用したるつぼと同じ材質(93%Al₂O₃-5%P₂O₅)の15番 るつぼを設置した。99.99%Alと99.9999%SiによりAl-7%Si-0ppmP合金1kgを溶製した。溶湯温度を700℃、 800℃、900℃、1000℃と変化させた。そして、一定時間 ごとに試料を採取してPの湿式分析を行った。その結果、 Fig. 16³⁴⁾に示すように、P量は700℃および800℃では、



Fig. 16 Effect of molten metal temperature on P content in Al-7%Si alloy melted in crucible including $P_2O_5^{34}$.

P₂O₅を含むるつぼで溶解したAl-7%Si合金溶湯中のP量 に及ぼす溶湯保持温度の影響³⁴⁾. **0ppm**から**3ppm**に増加した.また,**900**℃では**5ppm**に 増加し,さらに**1000**℃では**9ppm**に増加した.これより, 使用したるつぼから**P**が混入し得ることが判明した.

ところで、同図によると、比較的、溶湯温度の低い 700℃および800℃において、Pの増加量は3ppmと少ない. これに対して、前述した工業用の500kgの電気炉における 脱りん処理時には、溶湯温度が720℃であるにも関わらず 4~6ppmと、900℃の場合と同様に多く混入していた.こ の理由として、脱りん処理時のフラックスの発熱が関係し ている可能性がある.これを確認するため、脱りん処理時 の赤熱しているフラックス内の温度を、シース熱電対を用 いて測定した.その結果、870℃と高い温度が示された.こ のため、Fig. 16 における 900℃の場合 (5ppmの増加)と同 様に、多くのPが混入(4~6ppm)したものと推察される.

このような P の混入を防止する対策として,低融点であ る P_2O_5 をバインダーに用いないことが考えられる.そこで, P_2O_5 の代わりに,比較的高融点の CaO をバインダーとす る耐火物³⁹⁾を用いて 15 番るつぼを試作した.これを小型 の電気炉内に設置し,溶湯温度を 1000°Cに上昇させて試 験を行った.その結果,Pの混入は認められなかった³⁴⁾. また,720°Cにおける脱りん処理時のフラックスの発熱後 にも P の混入は認められなかった³⁴⁾.おそらく,耐火物が 局部的に溶融しないことにより,反応が生じにくくなった ものと思われる(固/液の反応速度).以上より,本脱りん 技術では Na 添加用フラックスに回転翼脱ガス装置を組み 合わせることに加え, P_2O_5 バインダーを使用しない耐火物 (CaO バインダー)を利用することが望まれる.

5. 結 言

本稿では脱りんを行う背景をやや詳しく述べた.また, 工業的な脱りん技術について述べた.この方法によると,P 量と同時に、ガス量と介在物量が低減された.また、溶湯 保持を行うとP量が増加する現象についての検討を行い, P_2O_5 バインダーを使用しない耐火物 (CaO バインダー)の 利用が望ましいことを述べた.

本稿は日本鋳造工学会の技術賞を受賞した脱りん技術を 技術報告としてまとめたものである.受賞にあたり御尽力 頂いた方々に,深く感謝の意を表する.

参考文献

- 1) G. Gürtler: Zeitschrift fuer Metallkunde 44 (1953) 503
- 2) P. Nölting: Gießerei 58 (1971) 509
- 3) S. Bercovici: Colloq Metall $\mathbf{20}~(1977)~455$
- 4) S. Bercovici: Gießerei 67 (1980) 522
- 5) C. R. Ho and B. Canter: Acta Metall. 43 (1995) 3231
- 6) 加藤鋭次, 野村宏之, 大城直人: 軽金属 46 (1996) 377

- 7) L. Heusler, W.Schneider: AFS Transactions 105 (1997) 915
- 8) 森中真行: 鋳造工学 75 (2003) 325
- T. H. Ludwig, P. L. Schaffer, L. Arnberg: Metallugical and Materials Transactions A 44A (2013) 5796
- 10) 森中真行: 鋳造工学 85 (2013) 508
- 11) 豊田充潤, 森中真行, 戸田裕之: 鋳造工学 86 (2014) 832
- 12) 津村善重:アルミニウム合金(1976)(金属通信社)265
- P. B. Crosley, L. F. Mondolfo: AFS Transactions 74 (1966) 53
- 14) S. M. Liang, R. Schmid-Fetzer: Acta Materialia 72 (2014)41
- 15) 森中真行, 豊田充潤: 鋳造工学 86 (2014) 823
- 16) 森中真行, 豊田充潤: 鋳造工学 84 (2012) 81
- 17) K. A. Jackson, J. D. Hunt: Trans. Met. Soc. AIME, 236 (1966) 1129
- C. M. Dinnis, A. K. Dahle, J. A. Taylor: Materials Science and Engineering A392 (2005) 440
- 19) 中村春香,岩崎出,門井浩太,中江秀雄:日本鋳造工 学会第159回全国講演大会概要集(2011)132
- 20) 豊田充潤,森中真行,小林正和,戸田裕之:日本鋳造 工学会第163回全国講演大会講演概要集(2013)36
- 21) W. A. Tiller, K. A. ackson, J. W. Rutter, B. Chalmers: Acta Metall., 1 (1953) 428
- 22) 森中真行,豊田充潤:日本鋳造工学会第167回全国講 演大会講演概要集(2015)79
- 23) 大城直人, 鈴木喬雄, 加藤鋭次: 軽金属 47 (1997) 337
- 24) 津村善重: 軽金属 16 (1955) 135
- 25) 森中真行: 鋳造工学 74 (2002) 383
- 26) 森中真行, 豊田充潤: 鋳造工学 85 (2013) 147
- 27) 森中真行, 豊田充潤: 鋳造工学 84 (2012) 334
- 28) 森中真行,下村勇一,豊田充潤,茜谷宗明:鋳造工学
 83 (2011) 125
- 29) 森中真行, 豊田充潤: 鋳造工学 86 (2014) 703
- 30) 森中真行, 豊田充潤: 鋳造工学 85 (2013) 197
- 31) 門井浩太,大開智哉,草本佑記,中江秀雄:鋳造工学
 82 (2010) 203
- 32) 森中真行, 豊田充潤: 鋳造工学 86 (2014) 781
- 33) 大信軽金属(株): Kモールド 10 倍拡大観察試験法 (1984)
- 34) 豊田充潤,森中真行,福武直人,長谷川豊:日本鋳造 工学会第167回全国講演大会講演概要集(2015)80
- 35) 森中真行: 鋳造工学 76 (2004) 897
- 36) 森中真行, 豊田充潤: 鋳造工学 85 (2013) 262
- 37) 中江秀雄, 松田泰明: 鋳造工学 72 (2000) 102
- 38) 軽金属学会:研究部会報告書 42 (2003)
- 39) カリデリス(株): アルミ炉用耐火物カタログ(2015)